

**ЗАО «ЭПЛ»****ПРОИЗВОДСТВО ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ**124460, Москва, Зеленоград, НИИМП, пр. 4806, д. 6, ЗАО «ЭПЛ». Тел./факс (095) 532-81-95,
тел.(095) 532-93-36. E-mail: epl@epl.ru, <http://www.epl.ru>**КТД8252 (А-А2,Б-Б2,В-В2,Г-Г2) Мощный NPN кремниевый транзистор**

АДБК.432140.953 ТУ

КТД8252 – биполярный эпитаксиально-планарный переключающий транзистор Дарлингтона со встроенным диодом Зенера и высоковольтным стабилитроном.

Прибор предназначен

для работы на индуктивную нагрузку в цепях электронного зажигания автотракторной техники и коммутаторах, а также в цепях управления электродвигателями и др. ключевых схемах.

Особенности прибора:

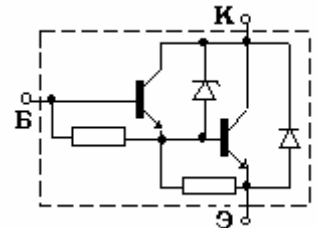
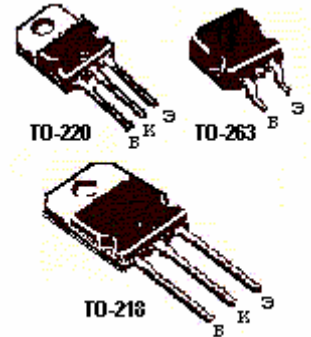
- Высокая рабочая температура р-п перехода
- высокий коэффициент усиления по току при низком напряжении насыщения во всём диапазоне рабочих температур
- 100% функциональный контроль в реальной цепи зажигания – гарантия устойчивости изделия к энергии вторичного пробоя.

Аналоги:

КТ890АМ, КТ898АМ, КТ8232, ВU323ZТ, ВU941ZР, ВU941ZТ, ST931ZТ,.

Выпускается в трёх корпусных исполнениях:

Пластмассовые корпуса **ТО-218(А,Б,В,Г), ТО-220(А1,Б1,В1,Г1), ТО-263(А2,Б2,В2,Г2)** и в бескорпусном исполнении - кристалл для использования в гибридных схемах.

**Предельно-допустимые режимы эксплуатации*.**

Параметры	Обозначение	КТД8252 А,А1,А2	КТД8252 Б,Б1,Б2	КТД8252 В,В1,В2	КТД8252 Г,Г1,Г2	Ед. измер
Напряжение коллектор-база	Uкбо	350	330	350	350	В
Напряжение коллектор-эмиттер	Uкэо	350	330	350	350	В
Напряжение эмиттер-база	Uэбо	5	5	5	5	В
Ток коллектора постоянный	Iк	15	15	15	15	А
Ток коллектора импульсный	Iки	30	30	30	30	А
Ток базы постоянный	Iб	1	1	1	1	А
Температура перехода	Tj	-65 ÷ +150	-65 ÷ +150	-65 ÷ +150	-65 ÷ +150	С°

* Рассеиваемая мощность коллектора - Pк max (Вт) для А,Б,В,Г – 120Вт; для А1,А2,Б1,Б2,В1,В2,Г1,Г2 – 75Вт.

Основные электрические параметры (Ткорп.=25 С°).

Параметры	Обозначение	Норма	Режим	Гр-па	Ед. изм.
Обратный ток коллектор-эмиттер	Iкэо	<50	Uкэ=300В Rб= ∞	А-В2	мкА
		<150		Г-Г2	
Напряжение коллектор-эмиттер граничное	Uкэогр	350-500	Iк=100мА, Iб=0	А-А2	В
		330-500		Б-Б2	
		350-500		В-В2	
		>350		Г-Г2	
Обратный ток эмиттер-база	Iэбо	<20	Uэб=5В	все	мА
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер	Uкэ.нас	<1,8	Iк=8А, Iб=0,1А	все	В
		<1,8	Iк=10А, Iб=0,25А	А-В2	
		<2(ТО-218)	Iк=12А, Iб=0,3А	А-В	
Напряжение насыщения база -эмиттер	Uбэ нас	<2,2	Iк=8А, Iб=0,1А	все	В
		<2,5	Iк=10А, Iб=0,25А	А-В2	
		<2,7(ТО-218)	Iк=12А, Iб=0,3А	А-В2	
		600-2000	Iк=5А, Uкэ=5В	А-А2	
350-2000	Б-Б2				
>1700	В-В2				
>160	Г-Г2				
Функциональный тест		10	Uпит=24В, L=7мГн	А-А2	А
		7		Б-Б2	
		10		В-В2	

«EPL» Semiconductor Devices Production.

124460, Moscow, Zelenograd, NIIMP, «EPL Ltd». Tel./fax +7(095) 532-81-95, tel.+7(095) 532-93-36.

<http://www.epl.ru>, E-mail: epl@epl.ru